



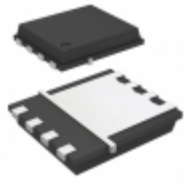





	<h2 style="color: red;">BSZ086P03NS3E G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	BSZ086P03NS3E G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	BSZ086P03NS3E G Infineon Technologies
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">BSZ086P03NS3E G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 25263 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	BSZ086P03NS3E G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSZ086P03NS3E G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	25263 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.1V @ 105µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.6 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4785pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57.5nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.5A (Ta), 40A (Tc)

BSZ086P03NS3E G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ086P03NS3E G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ086P03NS3E G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ086P03NS3E G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>BSZ086P03NS3 G</b> Infineon Technologies BSZ086P03NS3 G Infineon Technologies	 <b>BSZ086P03NS3G</b> Infineo BSZ086P03NS3G Infineo	 <b>BSZ086P03NS3EGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 40A TSDSON-8	 <b>BSZ086P03N</b> Infineon Infineon QFN8
 <b>BSZ076N06NS3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8	 <b>BSZ088N03L</b> Infineon Infineon QFN8	 <b>BSZ088N03LS</b> INFINEON BSZ088N03LS INFINEON	 <b>BSZ076N06NS3G</b> INFINEO BSZ076N06NS3G INFINEO

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ086P03NS3E G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ086P03NS3E G Datenblatt	BSZ086P03NS3E G-Datenblätter	BSZ086P03NS3E G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ086P03NS3E G
BSZ086P03NS3E G Electronic	BSZ086P03NS3E G-Komponenten	BSZ086P03NS3E G-Verteiler	BSZ086P03NS3E G-Bild	BSZ086P03NS3E G-Teil
BSZ086P03NS3E G Preis	BSZ086P03NS3E G Hersteller	BSZ086P03NS3E G Bild	BSZ086P03NS3E G Aktie	BSZ086P03NS3E G Inventar
BSZ086P03NS3E G Neu	BSZ086P03NS3E G Original	BSZ086P03NS3E G garantiert	BSZ086P03NS3E G RFQ	BSZ086P03NS3E G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited